Поз. обознач.		Наименование					١.	ı	Приме	ечание	
				Транз	висторы	11					
VT1VT11											
		Резисторы									
R1		700 Ом ±5%									
R2, R5		4 κOm ±5%									
R3		130 Om ±5%									
R4,R7		1 кОм ±5%									
R6		280 Ом ±5%									
R	.8	1,4 кОм ±5%									
R9		200 Ом ±5%									
R10		3 кОм ±5%									
R		530 Ом ±5%									
R12		30 O _M ±5%									
		50 S.n = 570									
							1				
							+				
					Курсової	йΠ	Проект				
						Л	um	/	Масса	Масштаб	
	Лист	<i>№ докум.</i> Хватов М.М.	Подпись	Дата	Широкополосный резистивный						
Разраб. Провер.		Хватов М.М. Болдырева Т.И.	хватов м.м. усилитель низкой частоты.								
Т. контр.		_ опдырова т.п.			ПЭ3	Лı	ıcm	1	Лис	тов 1	
Реценз.						<u> </u>		-	1		
Н. контр.							НИУ МЭИ каф. ФОРС				
Утверд.											